

Изобретение относится к области термоэлектрических материалов, а именно к способам рекристаллизации микропроводов из анизотропных материалов в стеклянной изоляции.

Способ рекристаллизации микропровода на основе висмута в стеклянной изоляции состоит в перемещении микропровода внутри конденсатора, образованного двумя медными пластинами, генерирующими сильное электрическое поле, нагреве микропровода лазерным лучом до температуры плавления жилы с образованием узкой расплавленной зоны, которая по ходу движения микропровода внутри конденсатора сразу кристаллизуется воздушным потоком, с направлением кристаллографической оси  $C_3$  микропровода по направлению электрического поля.

П. формулы: 1

Фиг.: 1